



T1069

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES FINOS DE NITRETO DE SILÍCIO POR DEPOSIÇÃO LPCVD

Frederico Hummel Cioldin (Bolsista CAPES - FIPSE) e Prof. Dr. Ioshiaki Doi (Orientador), Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação - FEEC, UNICAMP

Através da deposição química a partir da fase vapor auxiliada em baixa pressão(LPCVD), pretende-se obter filmes finos de nitreto (Si_3N_4) de silício sobre substratos de Si. O interesse nestes filmes isolantes finos e nesta tecnologia cresce à medida que aumentam os níveis de integração e de complexidade dos atuais dispositivos e circuitos eletrônicos com dimensões submicrométricas e nanométricas. Neste projeto, serão estudados filmes finos de nitreto (Si_3N_4) de silício de diferentes características preparados variando-se as condições de deposição, usando diferentes técnicas de caracterizações. E a partir de suas análises avaliadas as propriedades físicas e elétricas destes nitretos, além da uniformidade das deposições e de itens como a repetibilidade e a confiabilidade do processo de deposição destes filmes no nosso sistema de LPCVD.

Microfabricação - Nanotecnologia - Nitreto de silício